

## 特点

- 单 2.7V - 3.6V 电源
- 串行接口架构
- 页编程操作
  - 单周期重新编程 (擦除和编程)
  - 2048 页 (264 字节/页) 主内存
- 两个 264 字节的 SRAM 数据缓冲区 - 允许接收数据而非易失性存储器的重新编程
- 内部的计划和控制的定时器
- 快速页编程时间 - 7 毫典型
- 120 °C 典型的页面, 以缓冲传输时间
- 低功耗
  - 4 毫安有效的读电流典型
  - 8 °C 一种 CMOS 待机电流典型
- 5 MHz 的最大时钟频率
- 硬件数据保护功能
- 串行外设接口 (SPI) 兼容 - 模式 0 和 3
- CMOS 和 TTL 兼容输入和输出
- 商用和工业温度范围

## 描述

该 AT45DB041 是一个只有 2.7 伏, 串行接口闪存适合于系 TEM 重新编程。其 4325376 比特的存储器被组织为 2048 页 264 字节每个。除了在主存储器中, AT45DB041 还包含两个每 264 字节的 SRAM 数据缓冲区。该缓冲器允许接收而数据在主存储器页面进行重新编程。不同于传统的闪存 memo- 被访问随机与多个地址线和并行接口里斯, 该数据闪存采用串行接口以顺序存取其数据。简单的串行接口方便了硬件的布局, 提高了系统的可靠性, 减少了切换



# 4-Megabit

## 2.7 伏只

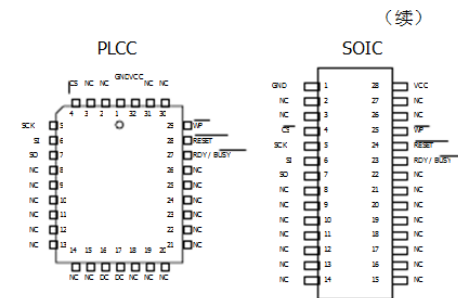
### 串行

### 数据闪存®

## AT45DB041

## 引脚网络connections

引脚名称	功能
CS	芯片选择
SCK	串行时钟
SI	串行输入
SO	串行输出
WP	硬件页写保护引脚
RESET	芯片复位
RDY / BUSY	就绪/忙

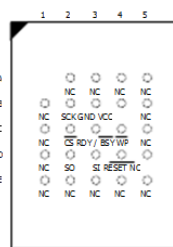


注: PLCC 封装引脚 16 和 17 请勿连接。

TSOP 顶视图  
类型 1



CBGAT 顶视图  
通过包装



数 00669D - 01



噪声, 并降低了封装尺寸和积极的引脚数。该装置被用在许多商业和工业优化试验应用高密度, 低引脚数, 低电压和低功耗是必不可缺的。典型应用对于数据闪存的数字化语音存储, 图像存储, 和数据的存储。该器件工作的时钟频率高达 5 兆赫与典型有效的读电流消耗为 4 mA。

为了让简单的系统内可重新编程中, AT45DB041 不要求高输入电压为亲

编程。该器件采用单电源工作支持 PLY, 2.7V 至 3.6V, 福尔波个 T 他的公 OGR 是一个可怕操作。该 AT45DB041 通过芯片使能通过三线接口选择引脚 (CS) 和访问由串行输入 (SI) 中, 串行输出 (SO) 和串行时钟 (SCK)。

所有的编程周期是自定时的, 并没有单独的编程前擦除周期。

框图

